

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載

【部門区分】第 2 部門第 1 区分

【発行日】平成25年3月28日 (2013.3.28)

【公開番号】特開2013-31842(P2013-31842A)

【公開日】平成25年2月14日 (2013.2.14)

【年通号数】公開・登録公報2013-008

【出願番号】特願2012-187000(P2012-187000)

【国際特許分類】

B 0 1 J 19/08 (2006.01)

C 0 3 C 23/00 (2006.01)

C 0 4 B 41/80 (2006.01)

H 0 1 L 21/306 (2006.01)

B 0 8 B 7/00 (2006.01)

B 0 8 B 3/08 (2006.01)

H 0 1 M 8/02 (2006.01)

H 0 1 M 8/10 (2006.01)

【 F I 】

B 0 1 J 19/08 E

C 0 3 C 23/00 A

C 0 4 B 41/80 Z

H 0 1 L 21/306 F

B 0 8 B 7/00

B 0 8 B 3/08

H 0 1 M 8/02 P

H 0 1 M 8/10

【手続補正書】

【提出日】平成25年1月4日 (2013.1.4)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0 0 8 4

【補正方法】変更

【補正の内容】

【 0 0 8 4 】

(n) 半導体の多層配線工程において、絶縁膜 2 3 上に溝 2 0 を設け、銅、アルミニウム、タングステン、チタンなどの金属膜 2 1 を埋め込み、絶縁膜 2 3 上の不要な金属膜 2 1 を除去するダマシンプロセス (Damascene process) にも利用できる。図 4 にダマシンプロセスの模式図を示す。図 4 において、a b c とプロセスが進み、c にて配線用金属のパターニングが形成される。

【手続補正 2】

【補正対象書類名】図面

【補正対象項目名】図 4

【補正方法】変更

【補正の内容】

【 図 4 】

